



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Gleichrichterdiode / Rectifierdiode				
Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \text{ max}}$	V_{RRM}	1600	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert (pro Element) RMS forward current (per chip)		I_{FRMSM}	60	A
Ausgangsstrom output current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$	I_d	105	A
Stoßstrom-Grenzwert surge forward current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$	I_{FSM}	650	A
	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$		550	A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$	I^2t	2100	A ² s
	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$		1500	A ² s
IGBT				
Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_C	50	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{CRM}	100	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	350	W
Gate-Emitter Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GE}	± 20	V
Schnelle Diode / Fast diode				
Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_F	25	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{FRM}	50	A
Modul				
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{min}$ NTC connected to baseplate	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Gleichrichterdiode / Rectifierdiode			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}, i_F = 100\text{A}$	V_F			1,30	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$	$V_{(TO)}$			0,75	V
Ersatzwiderstand forward slope resistance	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$	r_T			5,5	mΩ
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj \text{ max}}, V_R = V_{RRM}$	i_R			5	mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$R_{AA'+KK'}$			1	mΩ

prepared by: Ralf Jörke	date of publication: 13.12.2000
approved by: Lothar Kleber	revision: 1

Dioden-Modul mit Chopper-IGBT
Diode Module with Chopper-IGBT

DD B6U 104 N 16 RR

N



B6

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

IGBT			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_C = 50\text{A}, v_{GE} = 15\text{V}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}, i_C = 50\text{A}, v_{GE} = 15\text{V}$	$v_{CE\text{ sat}}$		2,10 2,5	2,80	V
Gate-Emitter-Schwellspannung gate-emitter threshold voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_C = 2\text{mA}, v_{GE} = v_{CE}$	$v_{GE(To)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, f_0 = 1\text{MHz},$ $v_{CE} = 25\text{V}, v_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}		3,3		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{CE} = 1200\text{V}, v_{GE} = 0\text{V}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}, v_{CE} = 1200\text{V}, v_{GE} = 0\text{V}$	i_{CES}		0,8 4,0	1	mA
Gate-Emitter Reststrom gate leakage current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{CE} = 0\text{V}, v_{GE} = 20\text{V}$	i_{GES}			500	nA
Emitter-Gate Reststrom gate-leakage current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{CE} = 0\text{V}, v_{EG} = 20\text{V}$	i_{EGS}			500	nA
Schnelle Diode / Fast diode						
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_F = 25\text{A}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}, i_F = 25\text{A}$	v_F		1,7 1,6	2,20	V
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$i_{FM} = 25\text{A}, -di/dt = 800\text{A}/\mu\text{s}, v_R = 600\text{V}$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	Q_r		2,3 6,0		μAs μAs

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand	Gleichrichter / Rectifier, $\Theta = 120^{\circ}\text{rect}$	R_{thJC}	max.	1,08	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
	Transistor / Transistor, DC		max.	0,38	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
	Schnelle Diode / Fast diode, DC		max.	1,00	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleichrichter / Rectifier	R_{thCK}	max.	0,25	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
	Transistor / Transistor		max.	0,24	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
	Schnelle Diode / Fast diode		max.	0,30	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj\text{ max}}$		150	$^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$		- 40...+150	$^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		- 40...+150	$^{\circ}\text{C}$

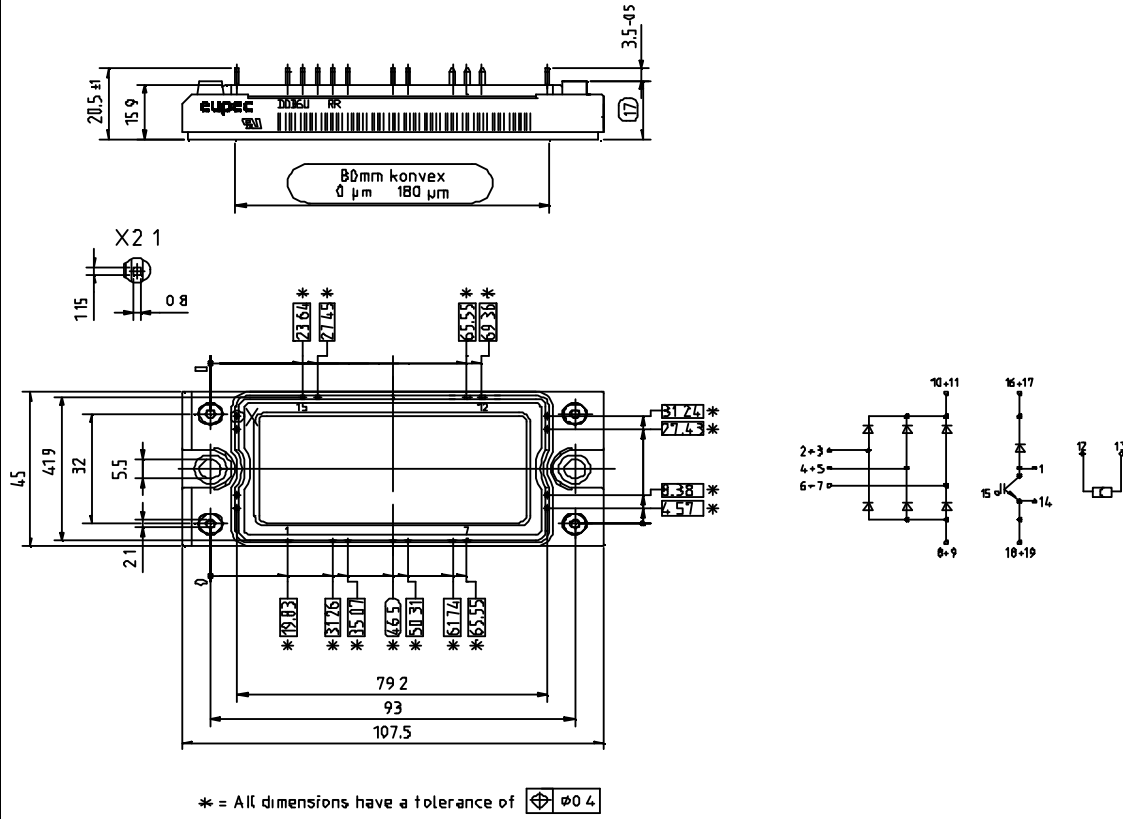
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 4 page 4	
Innere Isolation internal insulation			Al ₂ O ₃	
CTI comperative tracking index			225	V
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque	Toleranz / tolerance ±15%	M1	4	Nm
Gewicht weight		G	typ. 185	g
Kriechstrecke creepage distance			12,5	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	m/s ²

Temperatursensor / Temperature sensor

Nennwiderstand rated resistance	T _C = 25°C R ₁₀₀ = 493Ω ± 5%	R ₂₅	5	kW
Verlustleistung power dissipation	T _C = 25°C	P ₂₅	max. 20	mW
B-Wert B-value	R ₂ = R ₁ exp [B(1/T ₁ - 1/T ₂)]	B _{25/50}	3375	K

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. / This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

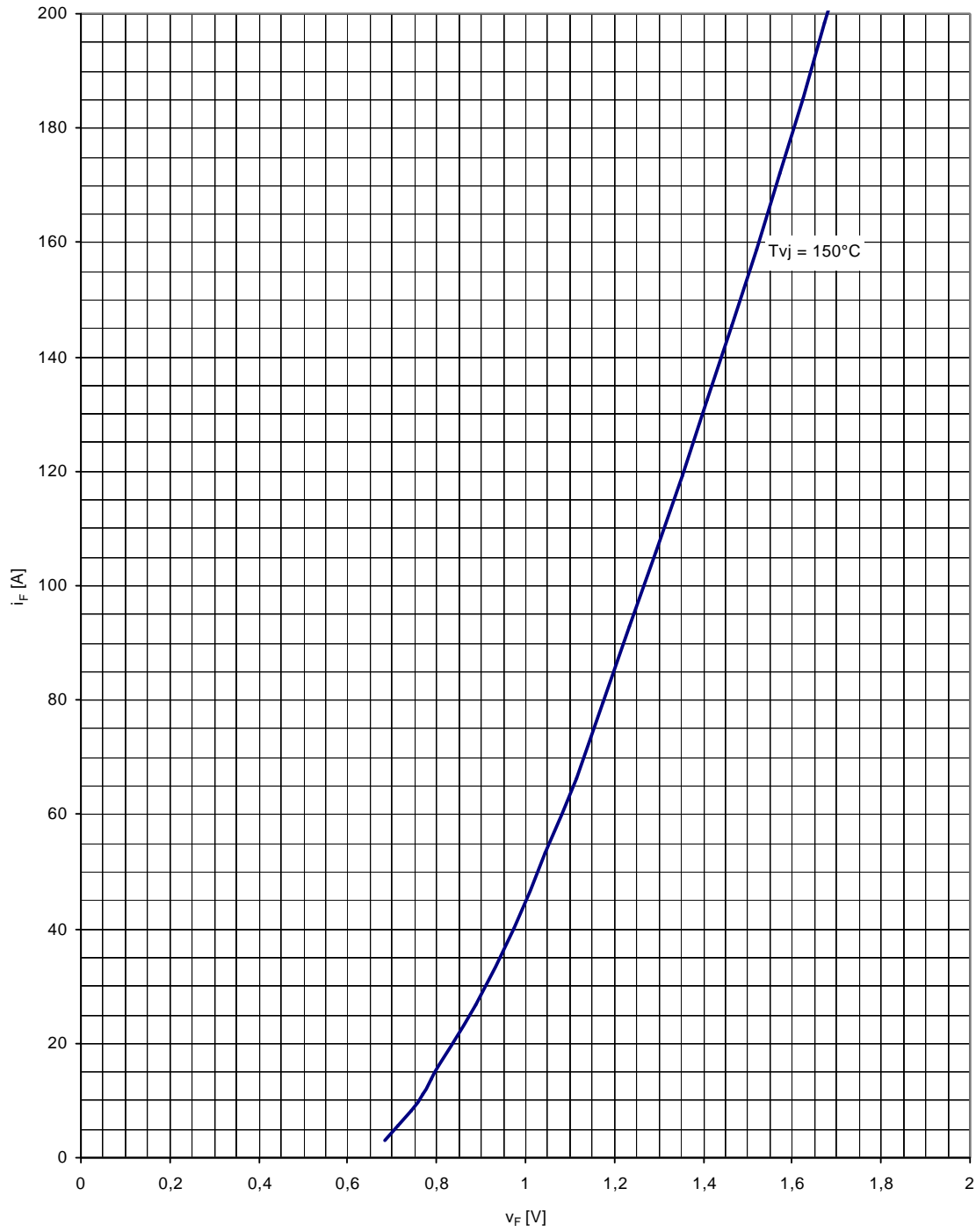


Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC, Netz-Diode

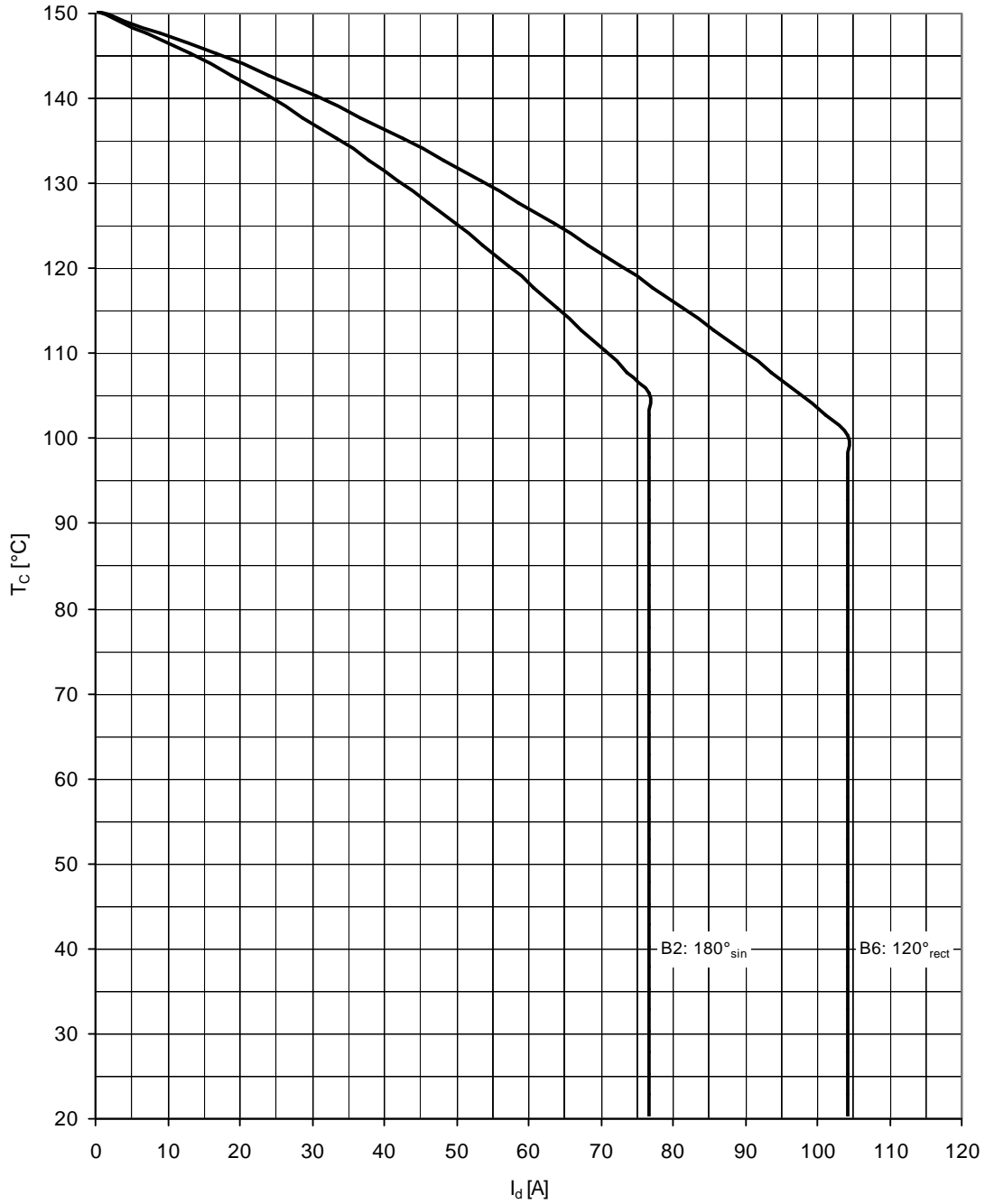
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC, rectifier diode

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,4063	0,3034	0,0497	0,0309			
$\tau_n [s]$	0,0300	0,0190	0,0140	0,0003			

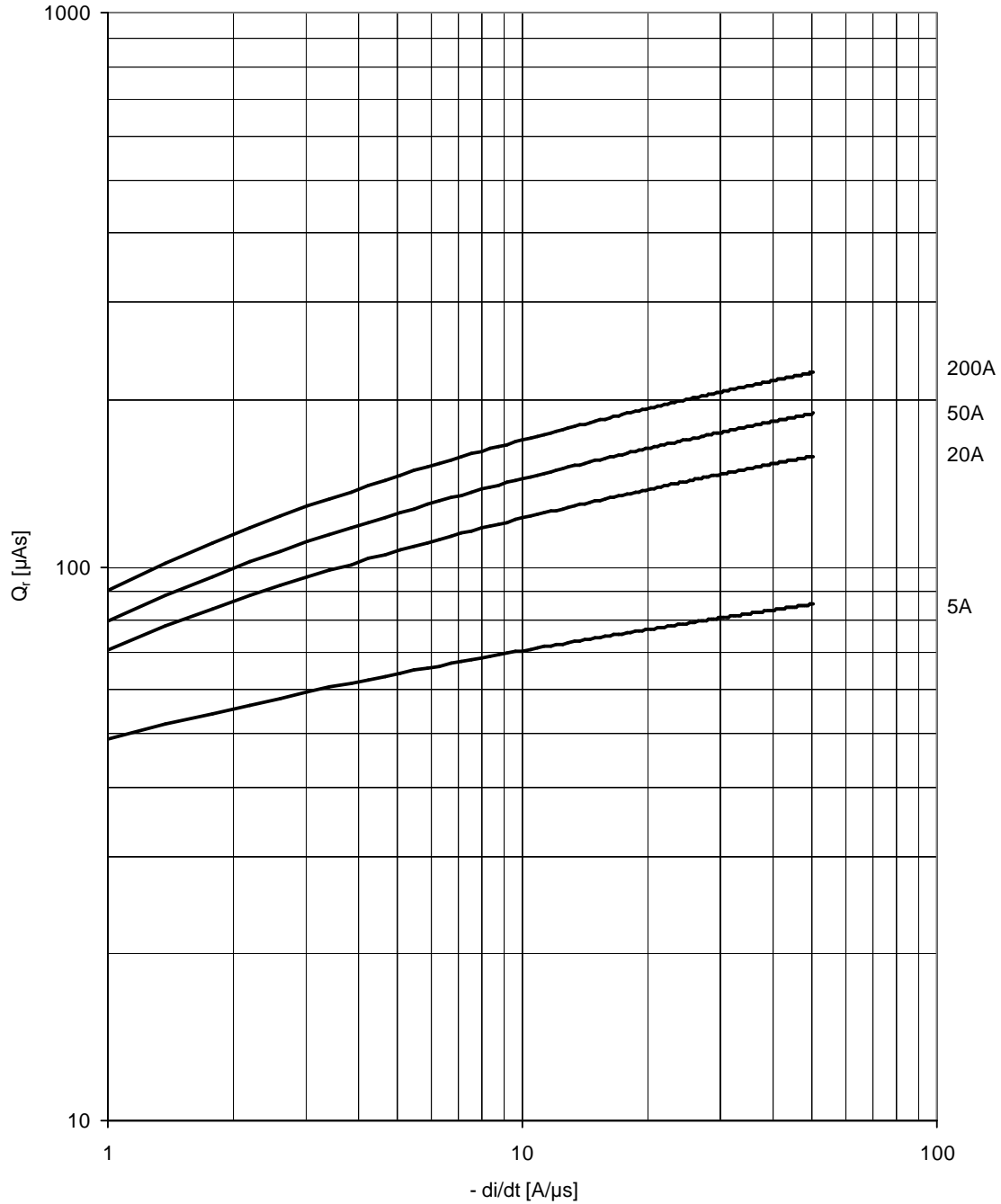
Analytische Funktion:
$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$



Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic $i_F = f(v_F)$



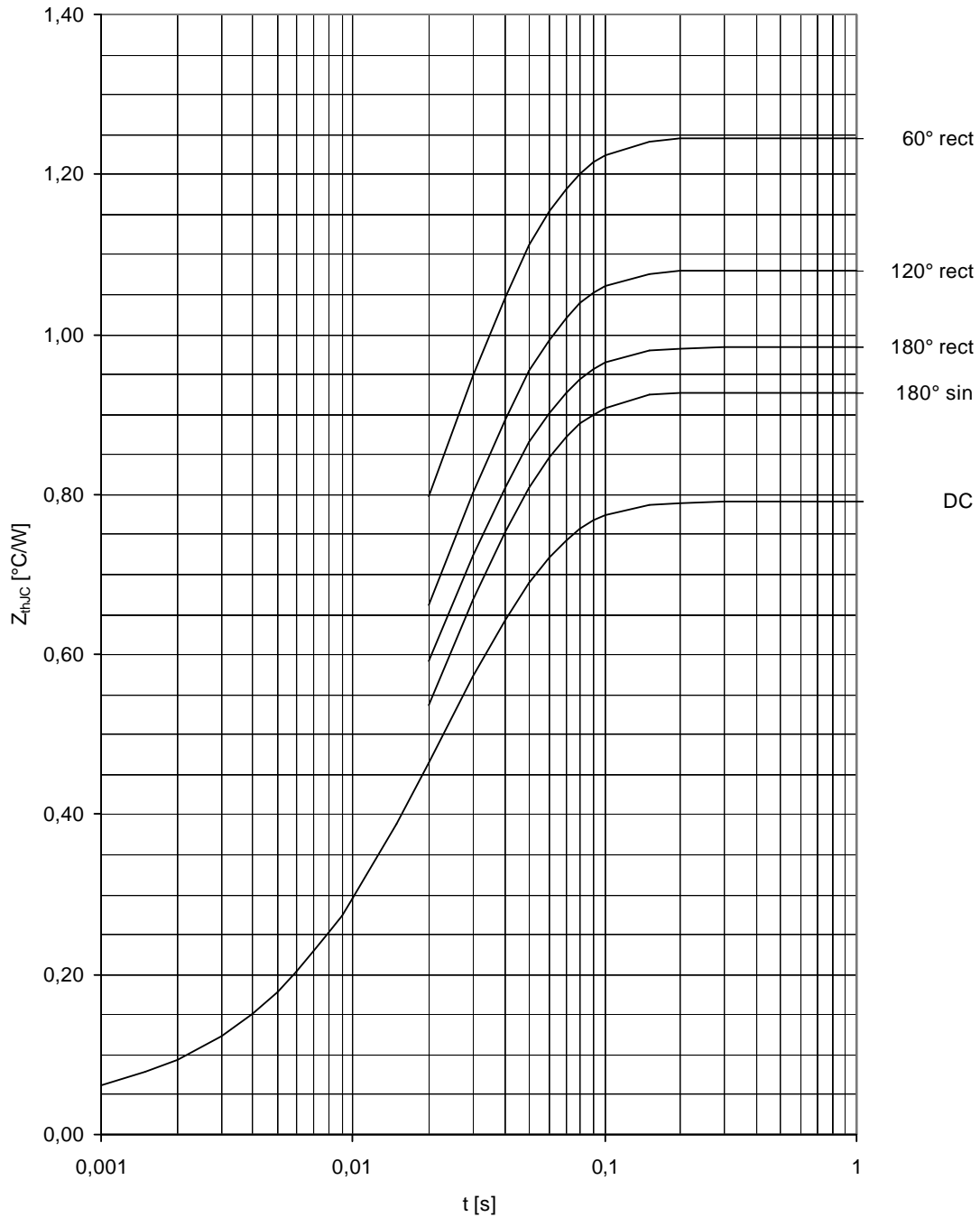
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperatur $T_c = f(I_d)$
Parameter: Stromrichterschaltung / converter circuit



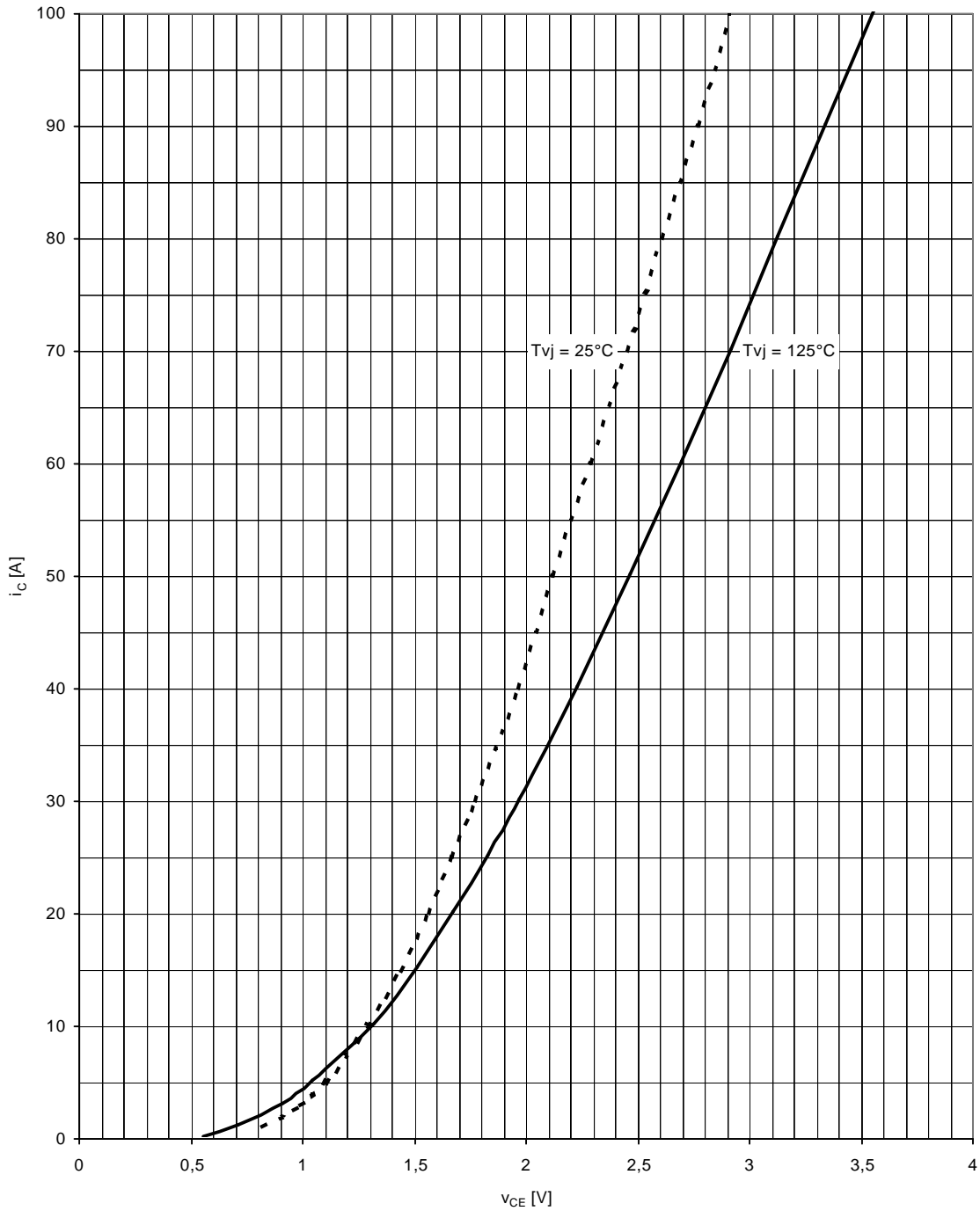
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

$T_{vi} = T_{vmax}$; $V_R = 0,5V_{RRM}$; $V_{RM} = 0,8V_{RRM}$

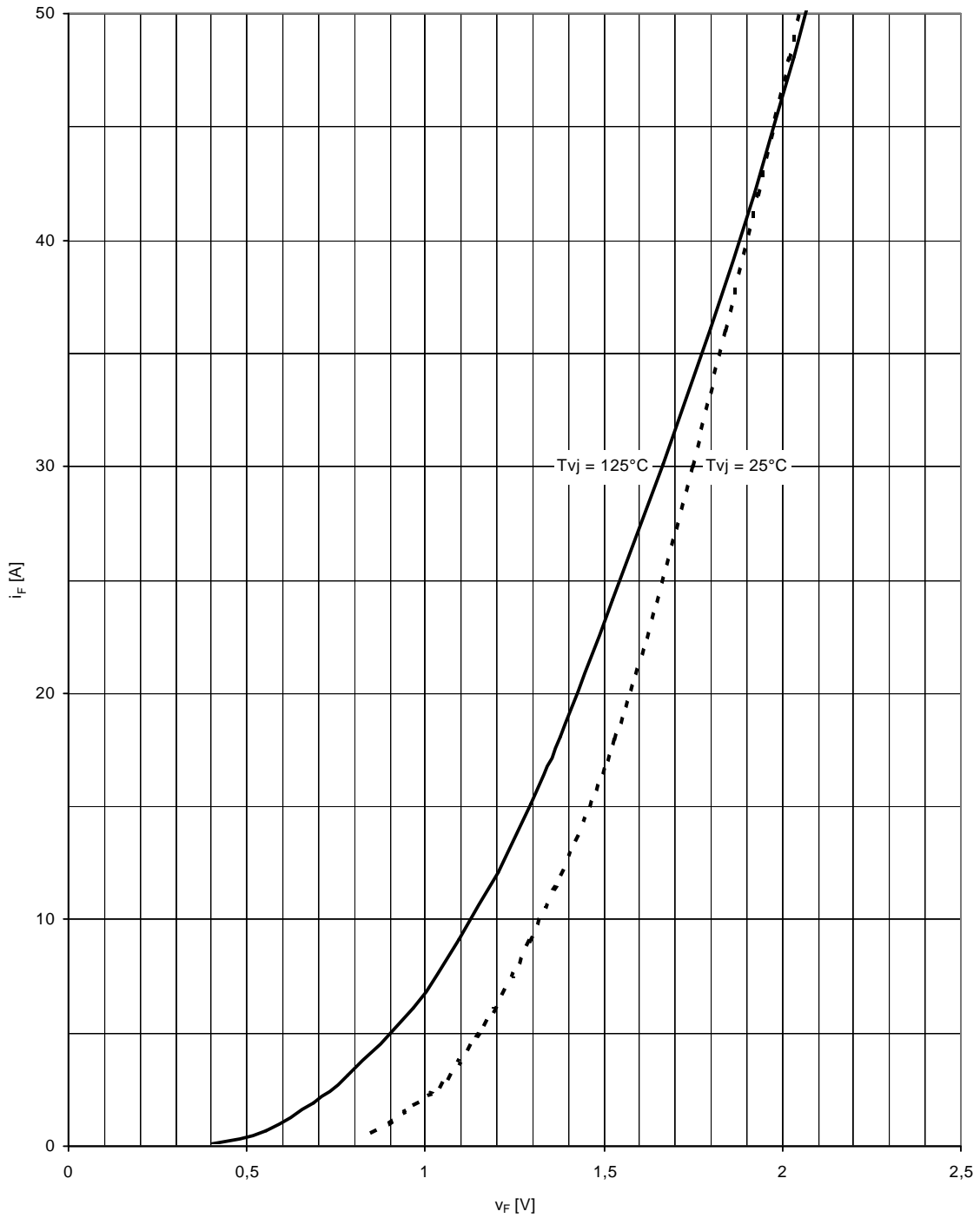
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{FM}



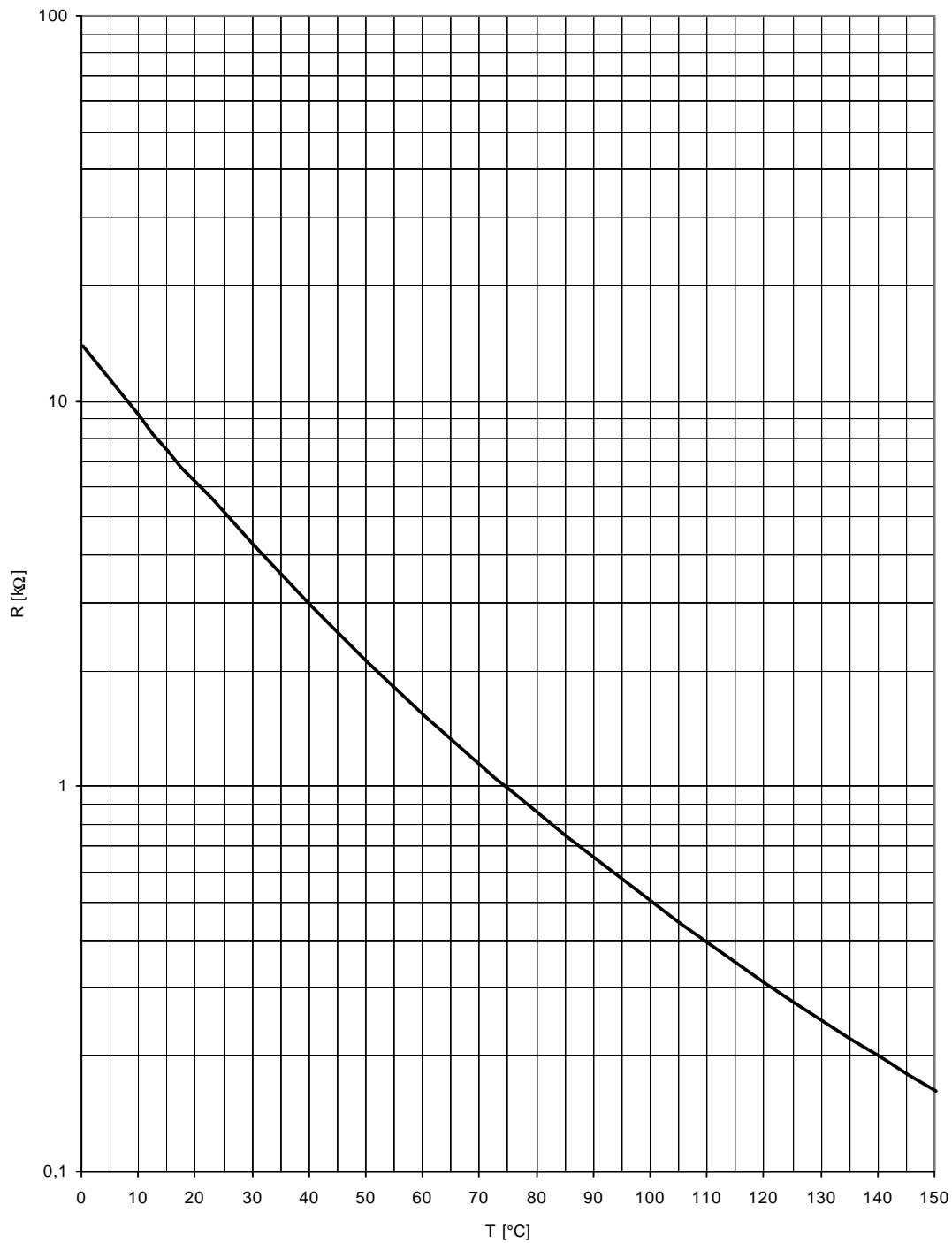
Transienter innerer Wärmewiderstand Gleichrichter / Transient thermal impedance converter $Z_{thJC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Q



Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch) / Output characteristic brake-chopper-IGBT (typical)
 $i_c = f(v_{CE}), v_{GE} = 15V$



Durchlaßkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch) / On-state characteristic of brake-chopper-FWD (typical)
 $i_F = f(v_F)$



NTC-Temperaturkennlinie (typisch) / NTC-temperature characteristic (typical) $R = f(T)$